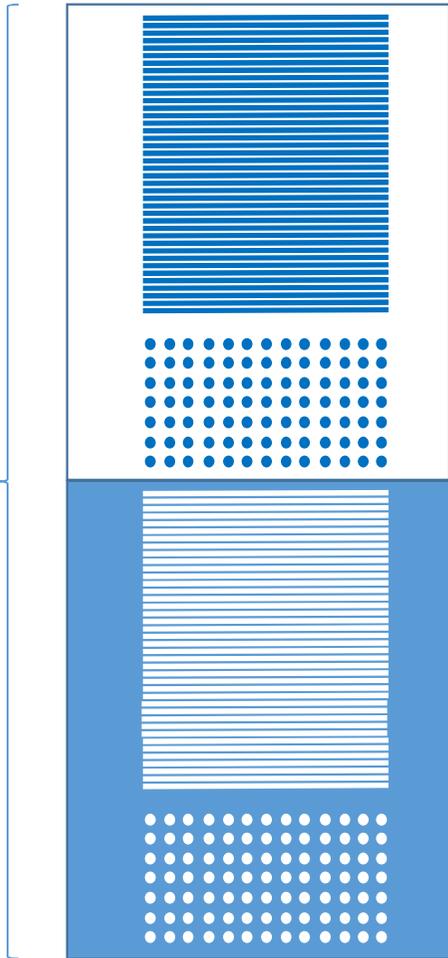


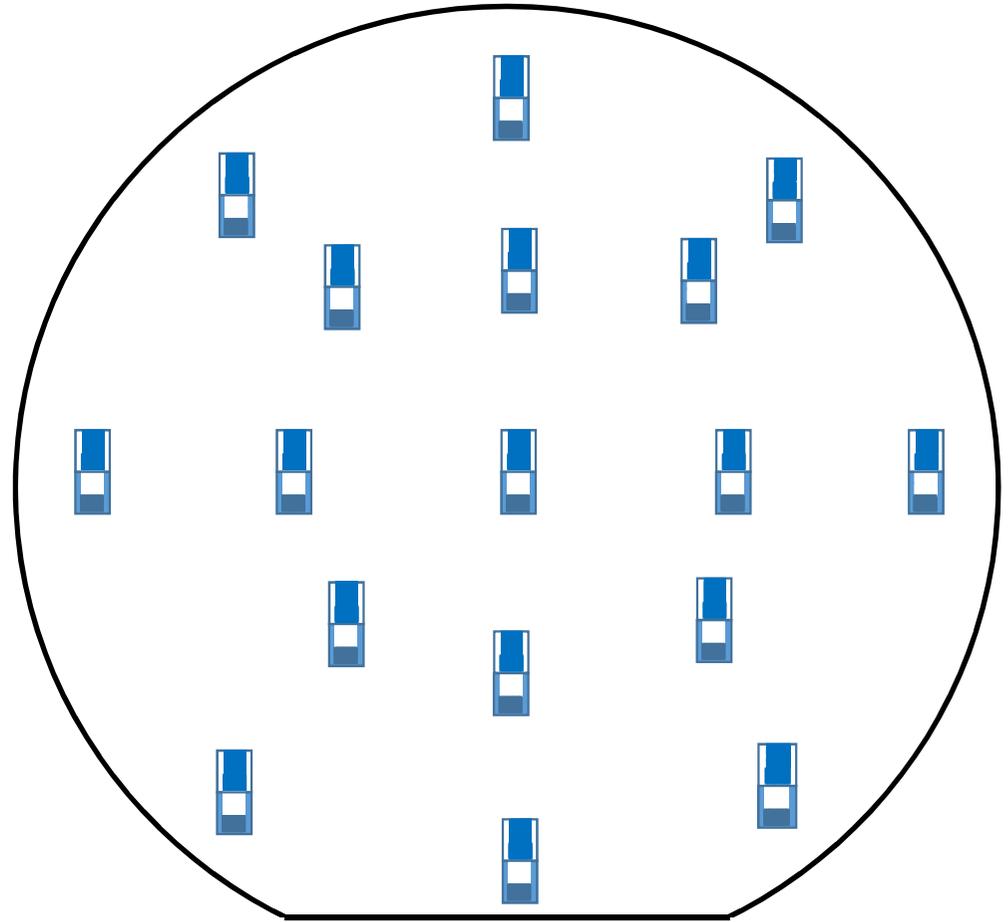
MASK 1

7mm

20
mm



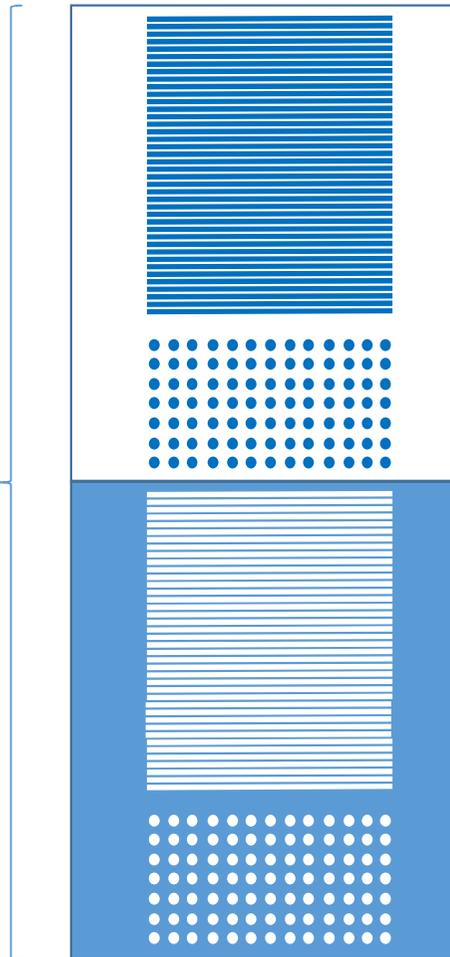
Distribuzione strutture su wafer: il fotoresist sarà solo sulle strutture ed il **95%** della fetta sarà esposto all'etching (**open**)



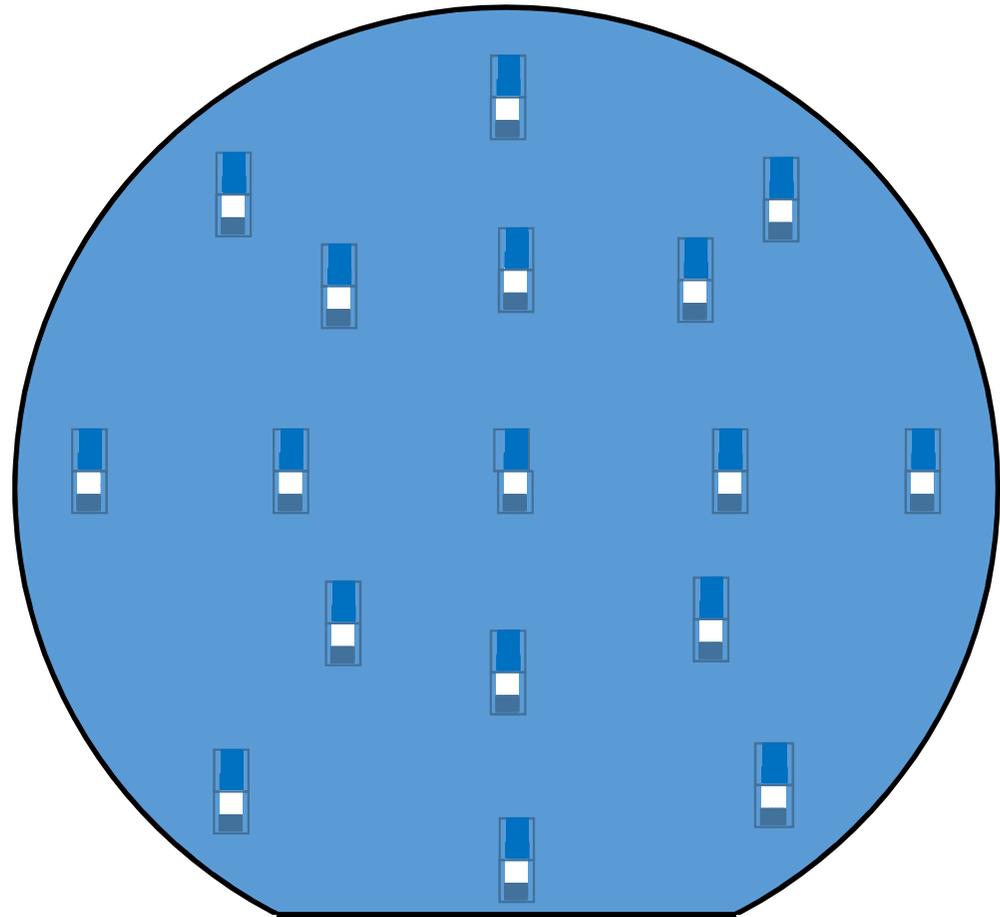
MASK 2

7mm

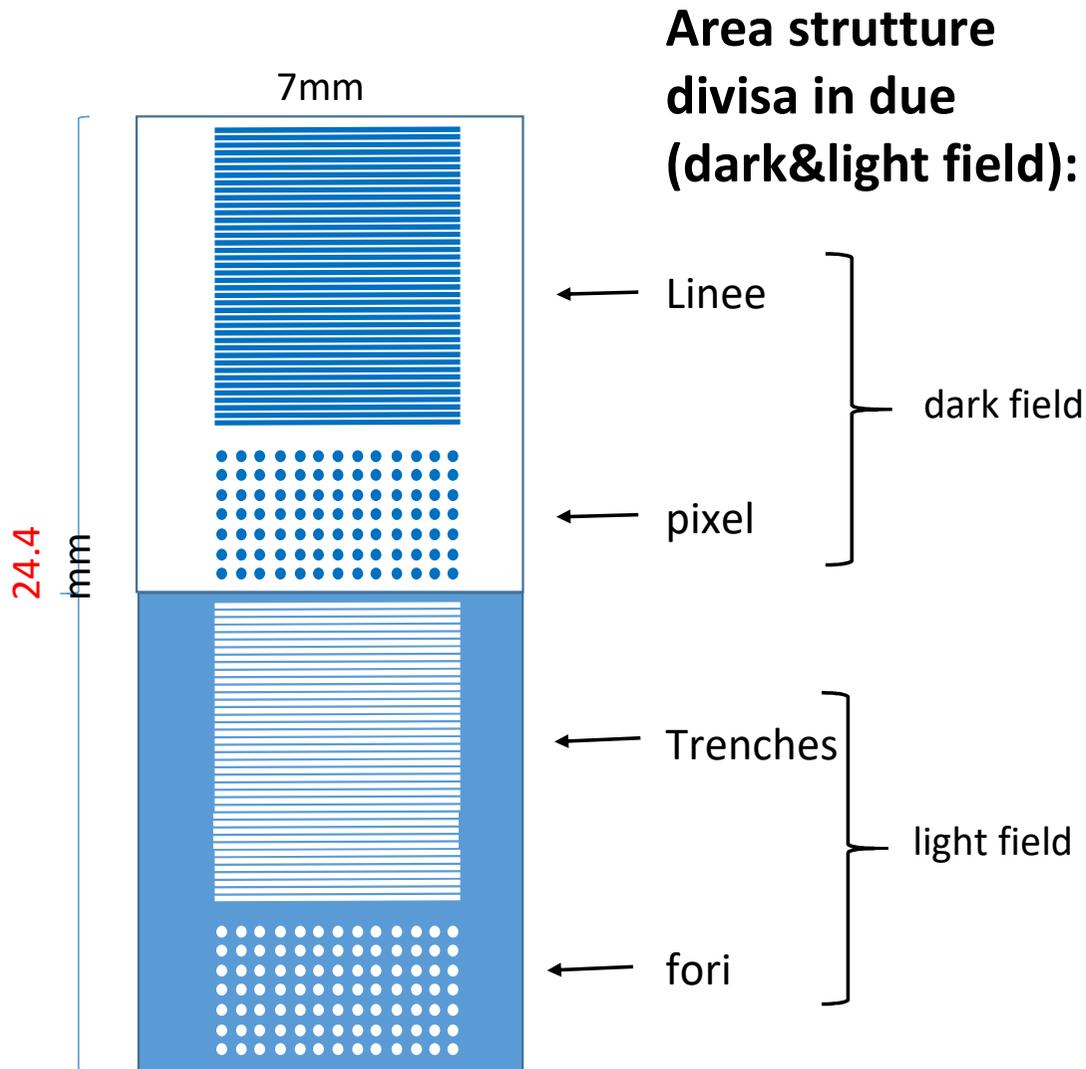
20mm



Distribuzione strutture su wafer: stessa distribuzione di maschera 1 per degli shot con strutture, ma in questo caso la fetta sarà per il **95%** coperta da fotoresist



MASCHERE PER TEST: SINGOLO SHOT



Matrice di linee/trenches

Linea 5 μ m	Passo 10 μ m	Passo 6 μ m	
Linea 3 μ m	Passo 6 μ m	Passo 4 μ m	
Linea 1 μ m	Passo 3 μ m	Passo 2 μ m	Passo 10 μ m
Linea 0.5 μ m	Passo 1.5 μ m	Passo 5 μ m	
Linea 0.35 μ m	Passo 1.5 μ m	Passo 5 μ m	
Linea 2 μ m	Passo 200 μ m		

Matrice di pixel/fori

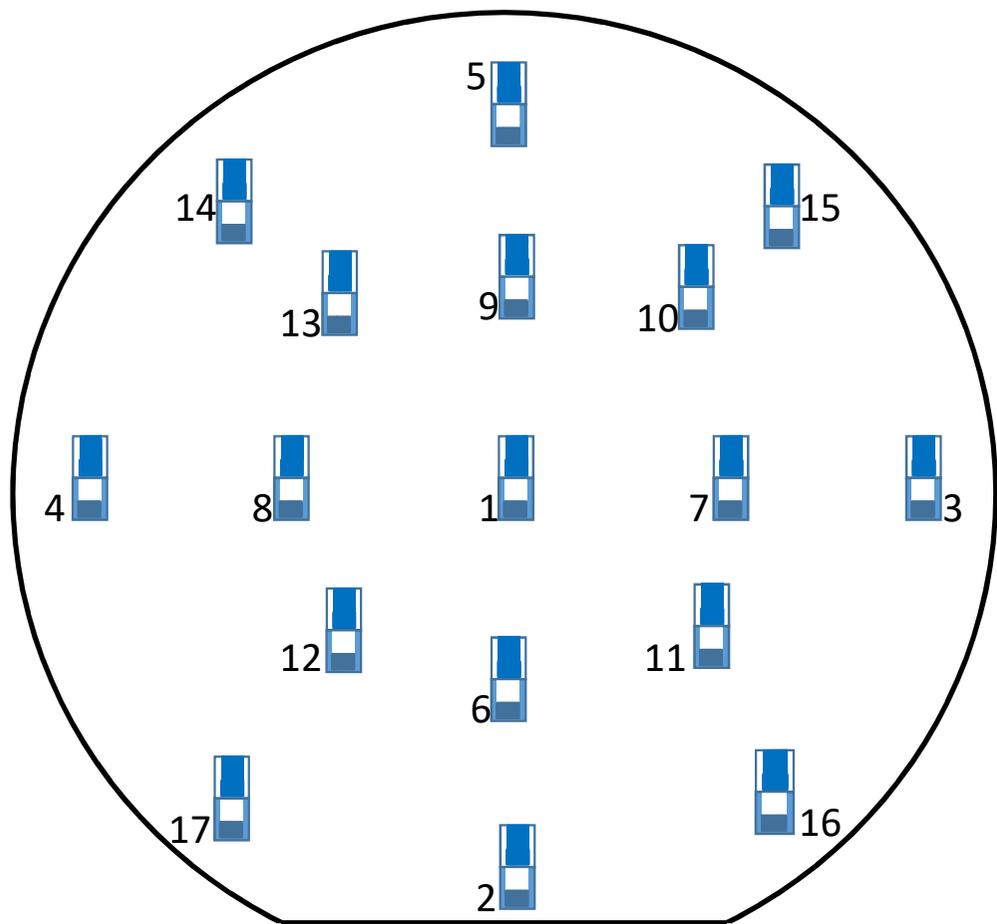
Foro 2 μ m	Passo 25 μ m
Foro 0.5 μ m	Passo 10 μ m
Foro 0.35 μ m	Passo 5 μ m

MASCHERA PER TEST: SINGOLO SHOT (2)

Strutture disegnate:
Varianti, numero e
distribuzione
all'interno dello shot

					spazio pervariante
larghezza disponibile Linee		7 mm			
n varianti Linee		11			
		636 um			0.636364 mm
larghezza disponibile Linee isolate		4 mm			
n varianti Linee isolate		1			
		4000 um			4 mm
larghezza disponibile Buchi		3 mm			
n varianti Buchi		3			
		1000 um			1 mm
linee	variante #	larghezza	passo	ripetizioni	spazio utilizzato [um]
	1	5	10	64	636.3636
	2	5	6	106	636.3636
	3	3	6	106	636.3636
	4	3	4	159	636.3636
	5	1	3	212	636.3636
	6	1	2	318	636.3636
	7	1	10	64	636.3636
	8	0.5	1.5	424	636.3636
	9	0.5	5	127	636.3636
	10	0.35	1.5	424	636.3636
	11	0.35	5	127	636.3636
n. varianti		11			7000
linee isolate	12	2	200	20	4000
buchi	13	2	25	40	1000
	14	0.5	10	100	1000
	15	0.35	5	200	1000
n. varianti		3			2000

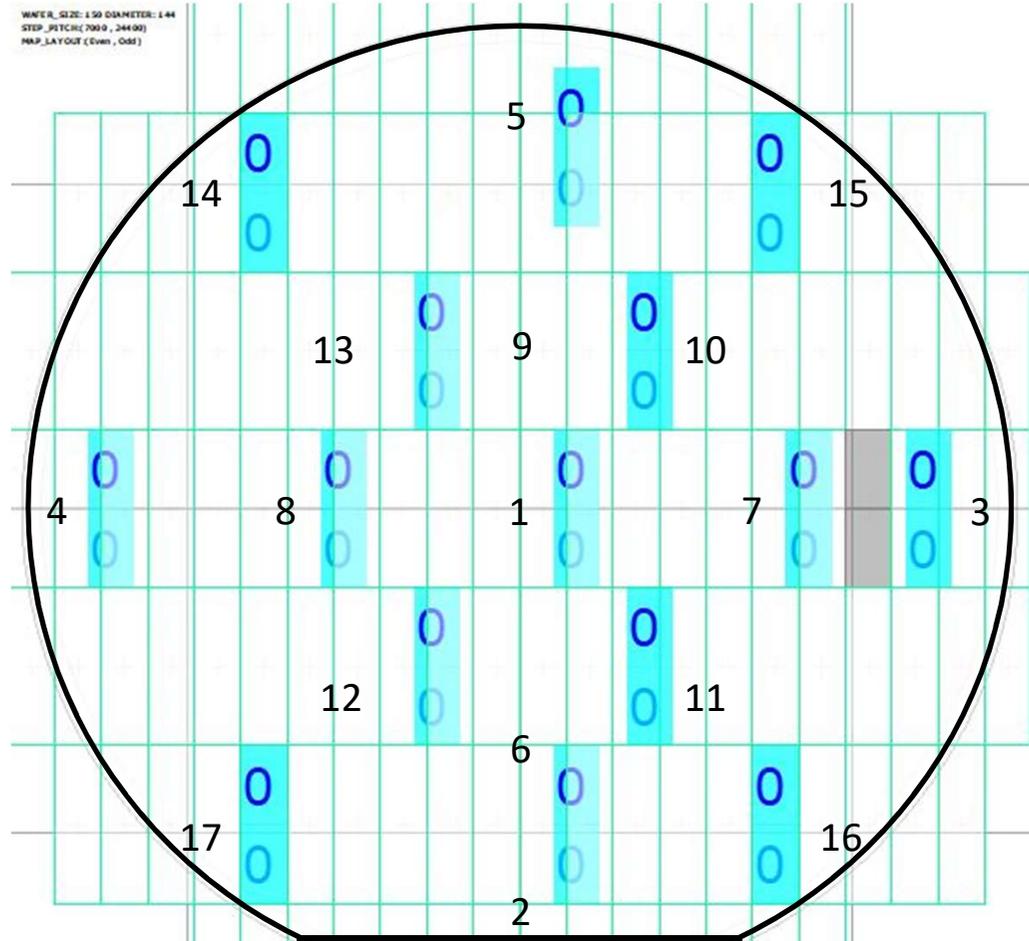
MAPPATURA UTILIZZATA PER LE MISURE DI SPESSORE CON INTERFEROMETRO E COORDINATE DEGLI SHOTS NELLE MASK 1 E 2



L'origine delle coordinate (0,0) è il centro della fetta
(misure in cm)

Posizione #	COORDINATE MISURE			COORDINATE SHOTS		
	x	y		Posizione #	x	y
1	0.00	0.00		1	0.50	0.50
2	0.00	-6.50		2	0.50	-6.00
3	7.00	0.00		3	6.50	0.50
4	-7.00	0.00		4	-6.50	0.50
5	0.00	7.00		5	0.50	6.50
6	0.00	-3.50		6	0.50	-3.00
7	3.50	0.00		7	4.00	0.50
8	-3.50	0.00		8	-3.00	0.50
9	0.00	3.50		9	0.50	4.00
10	2.47	2.47		10	2.97	2.97
11	2.47	-2.47		11	2.97	-1.97
12	-2.47	-2.47		12	-1.97	-1.97
13	-2.47	2.47		13	-1.97	2.97
14	-4.95	4.95		14	-4.45	4.95
15	4.95	4.95		15	4.45	4.95
16	4.95	-4.95		16	4.45	-4.45
17	-4.95	-4.95		17	-4.45	-4.45

WATER_SIZE: 150 DIAMETER: 144
STEP_SIZE: (7000, 24400)
MAP_LAYOUT (Even, Odd)



CROSS SECTION DEI TEST DA EFFETTUARE PER LA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DEI PARAMETRI DI PROCESSO CIASCUNA RICETTA

Ricetta #1 - test wafer per **SiO₂ etch** (item 2.1 dell'allegato 1- parametri)



Ricetta #2 - test wafer per **Si₃N₄ etch** (item 2.5 dell'allegato 1- parametri)

